



Рис. 1. Зависимости от поперечной координаты рассчитанного для положительно заряженных частиц с энергией 1 ТэВ эффективного потенциала плоскостей (110) кристалла германия, изогнутого с радиусом 5 м (а), концентрации электронов n_e и домноженной на квадрат атомного номера ($Z = 32$) концентрации ядер n_n (б).

Горизонтальный штриховой отрезок обозначает область устойчивого каналированного движения между точками поворота x_0 и x'_0 . Вертикальные пунктирные линии ограничивают область применения линейной аппроксимации эффективного потенциала в условиях резкого спада концентрации ядер вблизи левой точки поворота каналированного движения

Fig. 1. Effective potential of (110) germanium crystal planes evaluated for 1 TeV positively charged particles and 5 m bending radius (a); electron concentration n_e and multiplied by the atomic number $Z = 32$ squared nuclei concentration n_n (b).

The horizontal dashed line depicts the region of stable channeling motion between the turning points with coordinates of x_0 and x'_0 . The vertical dotted lines limit the region of linear effective potential approximation, applied under the sharp nuclear concentration drop near the left channeling motion turning point